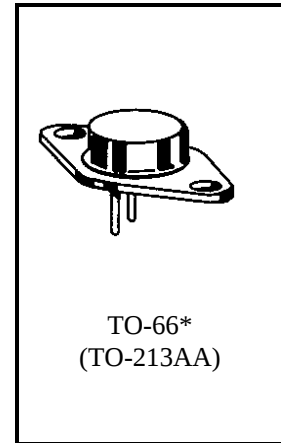


NPN POWER SILICON TRANSISTOR
Qualified per MIL-PRF-19500/518
Devices
2N3766
2N3767
Qualified Level
**JAN
JANTX
JANTXV**
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3766	2N3767	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0		Vdc
Base Current	I_B	2.0		Adc
Collector Current	I_C	4.0		Adc
Total Power Dissipation @ $T_C = +25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾	P_T	25		W
Operating & Storage Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	7.0	$^{\circ}\text{C/W}$

1) Derate linearly 143 mW/ $^{\circ}\text{C}$ between $T_C = +25^{\circ}\text{C}$ and $T_C = +200^{\circ}\text{C}$


*See Appendix A for Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100 \text{ mAdc}$	2N3766 2N3767	$V_{(BR)CEO}$	60 80	Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 80 \text{ Vdc}$	2N3766 2N3767	I_{CEO}	500 500	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 100 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$	2N3766 2N3767	I_{CEX}	10 10	μAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 80 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$	2N3766 2N3767	I_{CBO}	10 10	μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 6.0 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	500	μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽²⁾				
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 50 mAdc, V _{CE} = 5.0 Vdc I _C = 500 mAdc, V _{CE} = 5.0 Vdc I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 10 Vdc	h _{FE}	30 40 20	160	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 1.0 Adc, I _B = 0.1 Adc I _C = 0.5 Adc, I _B = 0.05 Adc	V _{CE(sat)}		2.5 1.0	Vdc
Base-Emitter Voltage I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 10 Vdc	V _{BE(on)}		1.5	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 500 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 10 MHz	h _{fe}	1.0	8.0	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, 0.1 MHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		50	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 30 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _B = 0.05 Adc	t _{on}		0.25	μs
Turn-Off Time V _{CC} = 30 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _B = I _B = 0.05 Adc	t _{off}		2.5	μs

SAFE OPERATING AREA**DC Tests**T_C = +25°C, 1 Cycle, t = 1.0 s**Test 1**V_{CE} = 6.25 Vdc, I_C = 4.0 Adc**Test 2**V_{CE} = 20 Vdc, I_C = 1.25 Adc**Test 3**V_{CE} = 50 Vdc, I_C = 150 mAdc 2N3766V_{CE} = 65 Vdc, I_C = 150 mAdc 2N3767

(2) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.